

平成 21 年 4 月 24 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独)日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 117 回研究会・委員総会 開催通知

日時：2009 年 5 月 18 日（月） 13:00 ～ 17:50

会場：明治大学 駿河台キャンパス アカデミーコモン 2 階 A2 会議室

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)

JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分

東京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分

都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線／神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ 「先端 L S I 用シリコン」 一次世代デバイスに向けた基板ウェーハ技術と結晶評価法－

世話人：金田 寛（新潟大学），村上 進（(株)日立製作所）

プログラム

13:00～13:05 開会の挨拶 田島 道夫

13:05～13:10 はじめに 金田 寛

13:10～13:50 「シリコンウェーハの完全性への要求」
佐藤 俊哉（富士通マイクロエレクトロニクス(株)）

13:50～14:30 「次世代半導体デバイスに向けた基板ウェーハの挑戦と課題」
泉妻 宏治（コバレントマテリアル(株)）

14:30～15:10 「低温超音波計測による L S I グレードシリコン結晶の原子空孔観測と評価」
後藤 輝孝（新潟大学）

15:10～15:30 休憩

15:30～16:10 「シリコン結晶の軽元素不純物と点欠陥の赤外吸収による評価－付：標準化とデータベースについて」

井上 直久（東京農工大学）

16:10～16:50 「シリコン結晶中 Cu の存在状態：電氣的，光学的測定」
中村 稔（(株)日立製作所）

16:50～17:30 トピックス：「単結晶シリコンの 3 次元加工」
小出 晃（(株)日立製作所）

17:30～17:35 おわりに 村上 進

17:35～17:50 委員総会

18:00～19:40 懇親会（場所：リバティータワー23階 サロン紫紺（研究会場の隣のビル））

以上